

# 年度考核报告

### 赵梅

中国科学院高能物理研究所 实验物理中心 电子学组



# 岗位职责

▶硅探测器设计与性能研究

LGAD探测器、 AC-LGAD探测器、SIPM探测器、HVCMOS探测器

▶完成项目内承担的各项工作

ATLAS HGTD项目、CEPC Ref-TDR河南项目、MOST 项目、 所创新、自然基金面上项目

▶完成领导交予的其他工作

# 本年度工作

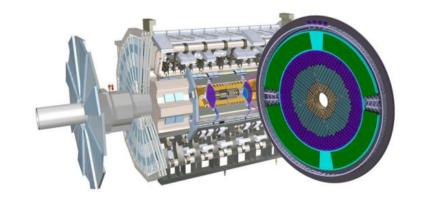
- ▶ATLAS HGTD LGAD探测器研究
- ▶AC-LGAD探测器研究
- ▶高压CMOS硅像素探测器研究
- ▶抗辐照SiPM器件研究
- ▶其他工作



### ▶ATLAS LHC升级HGTD项目

HGTD: High Granularity Timing Detector 高颗粒度高时间分辨探测器

▶LGAD传感器: Low Gain Avalanche Diode 总面积6.4m², ~21000个LGAD sensor



#### 参数要求:

像素大小: 1.3 x 1.3 mm<sup>2</sup>

像素阵列: 15x15

工作电压: <550V

时间分辨率: <50ps

抗辐照特性: 2.5e15 n<sub>eq</sub>/cm<sup>2</sup>

Hit efficiency at normal incidence with discrete/testing electronics and ALTRIROC (central part of pad ~1x1 mm <sup>2</sup> )	> 97% (>95%) before (after) irradiation
Time resolution (discreate/testing electronics) Time resolution (ALTIROC)	<40 ps (<50 ps) before (after) irradiation <50 ps (<70 ps) before (after) irradiation
Collected charge	>10 fC (>4 fC) before (after) irradiation
pad leakage current	<5 μΑ
Maximum V <sub>op</sub> Power supply limit at the sensors	11 V/μm ·D 800 V

#### >现有研究单位:

西班牙CNM、日本滨松HPK、意大利FBK,中国NDL,中国USTC等



□ ATLAS HGTD项目LGAD器件研究工作(sensor部分L2协调负责人)

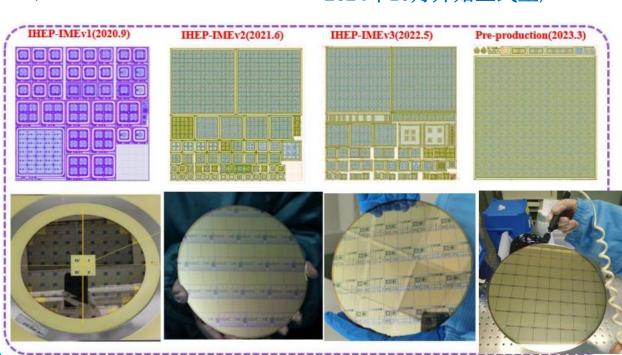
#### □ 高能所自主研发LGAD芯片方面:

IHEP-IMEv1(2020.9), 性能满足HGTD项目要求

IHEP-IMEv2(2021.6),具有最优的抗辐照性能,大阵列器件 2023年-2024年完成批量预生产

IHEP-IMEv3(2022.5), 工艺重复性验证, 优化大阵列器性设计0月开始正式生产

HGTD sensor部分 L2协调负责人 仿真、设计与测试 负责人: 赵梅





### 本年度具体工作

#### sensor预生产

- sensor预生产完成
- 性能评估完成
- 与ASIC联调测试
- 東流测试
- 预生产器件通过PRR

#### LGAD特性研究

- Sensor温度特性
- Sensor抗辐照特性

#### sensor正式生产

- 正式生产版图微调完成
- 流片讲行中

#### 测试系统

• 质量监控测试系统 与CERN、JSI、USP等单位一样

#### L2协调工作

- 国内器件生产
- 国内外单位测试工作
- HGTD sensor双周会议与季度会议
- HGTD 项目sensor计划与总结
- 参与人员工作评估



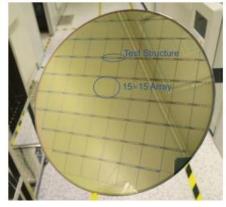
- 预生产sensor设计、制备、性能验证
  - ▶ IHEP芯片设计
    - 优化设计大阵列器件外围保护环结构

# 包含工艺验证测试结构 ← 15x15阵列器件

### ▶预生产完成情况

#### HGTD项目需求1085颗

Pre-production	Wat	ers	Sensors			
	IHEP-IME	USTC-IME	IHEP-IME	USTC-IME	Total	
Fabricated	90	90 27		1404	6084	
Passing preproduction requirements	52	13	1702	208	1910	
Pre-production with UBM, diced and tested by HGTD	23	5	789	118	907	





其他参与人员: 孙维益(学生), 张田园(学生), 梁志均



### ▶预生产sensor设计、制备、性能验证

- Vendor测试数据分析,确定是否满足HGTD Specification
- •Sensor 抽检与测试,IHEP测试:大阵列芯片测试,QC-TS结构的各项性能测试

IHEP-IME:	
52 wafers be tested	
by IME.	
Good sensors~1700	)

Here is list of 27 wafers that be diced and tested by HGTD (23 wafers with UBM, Good sensors with – UBM: 789)

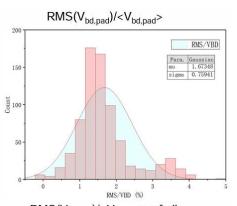
ATLAS ID WS0000110002 WS0000110003 WS0000110016 WS0000200012 WS0000110005 WS0000200016 WS0000200016	IHEP-IME ID v1-R2(w1) v1-R3(w2) v1-A16(w3) v2-12(w4) v1A15 v1R5 v216	775 775 775 775 775	Average Vbd (V) 212.7 222.5 196 180.8 217.7	per wafer 19 25 18 39 22	sensor yield 36.50% 48% 35% 75% 48%	UBM no no no no
WS0000110003 WS0000110016 WS0000200012 WS0000110015 WS0000110005 WS0000200016	v1-R3(w2) v1-A16(w3) v2-12(w4) v1A15	775 775 775 <b>775</b>	222.5 196 180.8	25 18 39	48% 35% 75%	no no no
WS0000110016 WS0000200012 WS0000110015 WS0000110005 WS0000200016	v1-A16(w3) v2-12(w4) v1A15 v1R5	775 775 <b>775</b>	196 180.8	18 39	35% 75%	no no
WS0000200012 WS0000110015 WS0000110005 WS0000200016	v2-12(w4) v1A15 v1R5	775 <b>775</b>	180.8	39	75%	no
WS0000110015 WS0000110005 WS0000200016	v1A15 v1R5	775				
WS0000110005 WS0000200016	v1R5		217.7	22	40%	
WS0000200016					4070	yes
WS0000200016		000				
	v216	300	190	42	80.77%	yes
WS0000300010	V210	300	201.7	40	76.92%	yes
	V310	300	196.1	31	59.62%	yes
WS0000400007	V4-7	300	169.9	31	59.62%	yes
WS0000400009	V4-9	300	168.2	33	63.46%	yes
WS0000400011	V4-11	300	170.8	39	75.00%	yes
WS0000400012	V4-12	300	170.7	33	63.46%	yes
WS0000400014	V4-14	300	162.1	30	57.69%	yes
WS0000400015	V4-15	300	172	39	75.00%	yes
WS0000400020	V4-20	300	177.8	28	53.85%	yes
WS0000400022	V4-22	300	160	26	50.00%	yes
WS0000400024	V4-24	300	178.1	31	59.62%	yes
WS0000400001	V4-1	300	178.1	43	82.69%	yes
WS0000400003	V4-3	300	167.4	6	11.54%	yes
WS0000400013	V4-13	300	174.9	40	76.92%	yes
WS0000400023	V4-23	300	164.8	34	65.38%	yes
WS0000300001	V3-1	300	178.1	43	82.69%	yes
WS0000300005	V3-5	300	172.3	36	69.23%	yes
	V3-15	300	177.6	38	73.08%	yes
WS0000300015	V3-22	300	176.6	44	84.62%	yes
	V3-23	300	171.1	39	75.00%	yes
	WS0000400001 WS0000400003 WS0000400013 WS0000400023 WS0000300001 WS0000300005 WS00003000015	WS0000400001 V4-1 WS0000400003 V4-3 WS0000400013 V4-13 WS0000400023 V4-23 WS0000300001 V3-1 WS0000300005 V3-5 WS0000300015 V3-15 WS0000300022 V3-22	WS0000400001 V4-1 300 WS0000400003 V4-3 300 WS0000400003 V4-13 300 WS0000400023 V4-23 300 WS0000300001 V3-1 300 WS0000300005 V3-5 300 WS00003000015 V3-15 300	W\$0000400001 V4-1 300 178.1 W\$0000400003 V4-3 300 167.4 W\$0000400003 V4-13 300 174.9 W\$0000400023 V4-23 300 164.8 W\$0000300001 V3-1 300 178.1 W\$0000300005 V3-5 300 172.3 W\$00003000015 V3-15 300 177.6	WS0000400001 V4-1 300 178.1 43 WS0000400003 V4-3 300 167.4 6 WS0000400013 V4-13 300 174.9 40 WS0000400023 V4-23 300 184.8 34 WS0000300001 V3-1 300 178.1 43 WS00003000015 V3-5 300 172.3 36 WS0000300015 V3-15 300 177.6 38	WS0000400001 V4-1 300 178.1 43 82.69% WS0000400003 V4-3 300 167.4 6 11.54% WS0000400013 V4-13 300 174.9 40 76.92% WS0000400013 V4-23 300 164.8 34 65.38% WS0000300001 V3-1 300 178.1 43 82.69% WS0000300001 V3-1 300 178.1 43 82.69% WS0000300005 V3-5 300 172.3 36 69.23% WS0000300015 V3-15 300 177.6 38 73.08% WS000030002 V3-22 300 176.6 44 84.62%

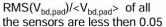


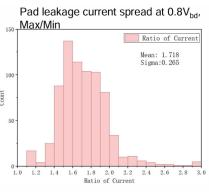
#### 预生产LGAD器件特性满足项目要求:

- ➤ Vendor测试、数据上传
- ▶ IHEP大阵列抽检测试
- ➤ CERN、USP等单位质量监控测试
- ➤ JSI 抗辐照性能测试

#### 2024年7月预生产的评审PRR通过







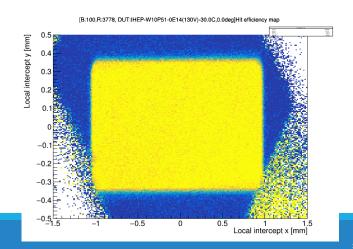
Pad leakage current spread at  $0.8V_{bd}$ , peak to peak within a factor of 3X

其他参与人员: 孙维益(学生), 张田园(学生), 梁志均



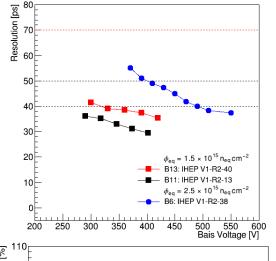
### ▶预生产sensor设计、制备、性能验证

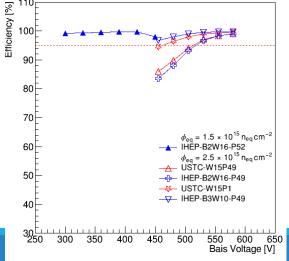
• 辐照前后器件性能测试(束流测试)



预生产LGAD器件辐照前后的时间和收集电荷 性能完全满足项目指标要求

(项目指标辐照后>4fC,时间性能好于50ps)





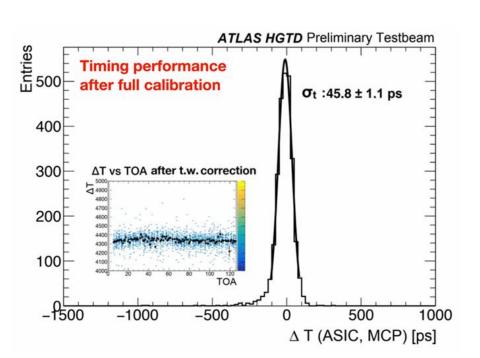
其他参与人员: Khuram, 大川

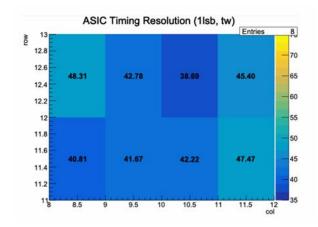
ç

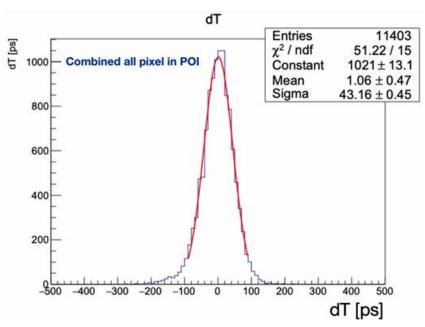


### ▶预生产sensor设计、制备、性能验证

• Sensor与ASIC键合良好,模块辐照前后时间分辨均可达到50ps以下







其他参与人员: 杨轩(博后),孙维益(学生),贾雪薇(学生),梁志均,庄胥爱

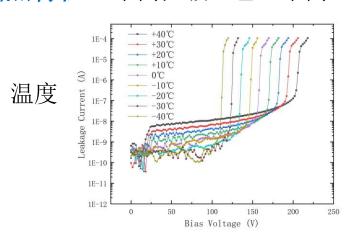


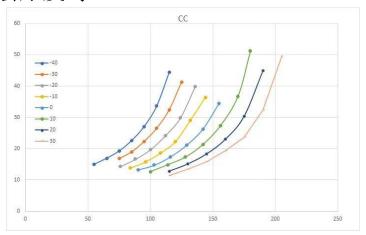
# LGAD探测器

### ▶ LGAD温度特性与抗辐照性能研究

温度特性: 器件击穿、时间分辨、收集电荷等性能随温度变化的特性研究

抗辐照特性:不同注碳工艺,不同EPI层厚度等





其他参与人员: 孙维益(学生), 梁志均

多碳工艺 JTE gain layer - p<sup>+</sup>
Epitaxial layer - p<sup>+</sup>
substrate - p<sup>++</sup>

V3W22 Doping profiled — Carbon — Boron — Boron — Carbon — Boron — Carbon — Boron — Carbon — C

其他参与人员: 冯缘(学生), 类云云,梁志均 A simple monte carlo scheme

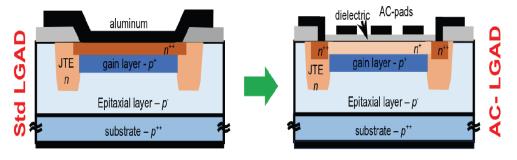
Wafer	W20	W21	W22	W0
C (1e-16cm2) proton	2.48	1.63	1.44	3.11
C (1e-16cm2) netron	-	-		
C (neutron) Assumption 1	1.18	0.74	0.50	
C (neutron) Assumption 2	1.10	0.82	0.70	-
Potic (proton / poutron)	2.10	2.20	2.88	2.93
Ratio (proton / neutron)		1.99	2.06	2.93

DRD3 project: Study of irradiation characteristics of carbon enriched LGAD for high radiation fluence application



### ➤ AC-LGAD器件

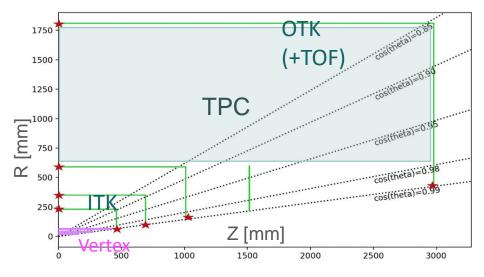
- ▶填充系数100%, 可实现<10um位置分辨
- ▶兼具高时间(50ps)与空间(<10um)分辨率
- **CEPC**内部和端盖的baseline方案

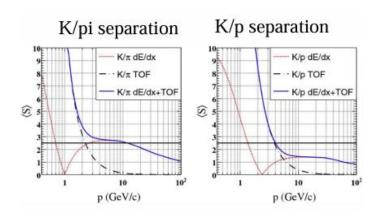


AC-LGAD器件:在LGAD器件内部放置交流耦合的像素单元与电极,所有像素单元共用一个增益层

优点:可以只在像素阵列外围设置保护环结构而中间无需类似结构,在器件内部几乎无探测死区。

#### **▶CEPC OTK&TOF应用**







### ▶ 本年度具体工作

- AC-LGAD器件性能测试
- CEPC Ref-TDR 方案讨论与撰写
- 针对CEPC应用,进行第三版芯片仿真、设计

### IHEPAC-LGAD R&Dv2 测试

- 器件测试板制备
- 器件性能测试 (IV, CV, 时间、位置)

#### **CEPC Ref-TDR**

- 方案讨论
- 探测器性能评估
- 河南项目预算与申请书撰写
- TDR文案撰写

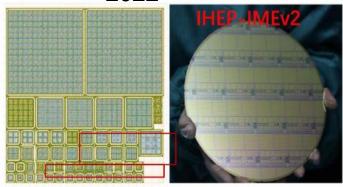
# CEPC应用AC-LGAD设计

- 芯片仿真
- 版图设计
- 工艺参数设定
- 低噪声2级测试板设计



#### ▶ AC-LGAD器件流片



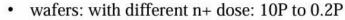


#### AC-LGAD R&Dv1:

#### Pixeled AC-LGAD

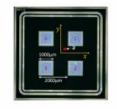
 With different pad-pitch size 1000-2000um 100-500um 100-200um

50-100um

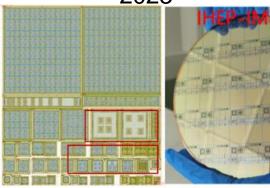


#### Process parameters be studied.

The performance of large-pitch AC-LGAD with different N+ dose, Trans. Nucl. Sci., 2023.6



#### 2023



#### AC-LGAD R&Dv2:

Pixeled and strip AC-LGAD

 With different pad-pitch size 1000-2000um pixel 100-250um strip 100-150um strip

50-100um strip



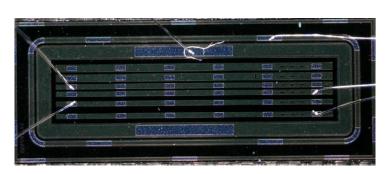
wafers: with different n+ dose:0.2P to 0.01P

The performance of AC-coupled Strip LGAD developed by IHEP, NIMA, Volume 1062, May 2024, 169203

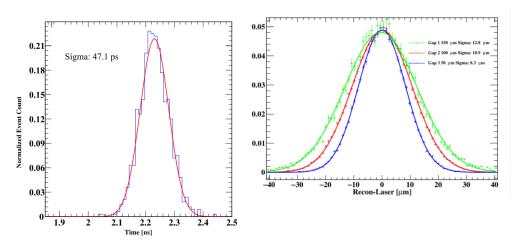
工艺与设计、测试负责人: 赵梅 参与人员: 李梦朝(博后), 孙维益(学生), 梁志均 张晓旭(南大学生), 张雷(南大)



### ➤ AC-LGAD器件R&Dv2测试

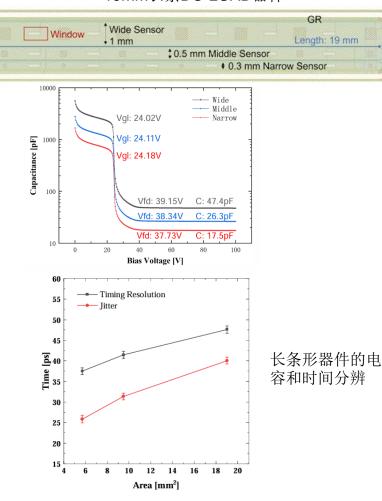


5.6mm长条AC-LGAD器件



时间37.5ps (Beta测试) 位置8.3um (激光测试)

#### 19mm长条DC-LGAD器件



其他参与人员: 李梦朝(博后), 孙维益(学生), 梁志均张晓旭(南大学生), 张雷(南大)

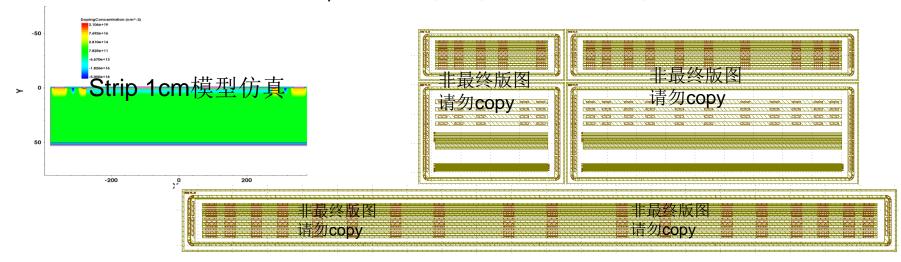
Parallel

Perpendicular

### ➤ CEPC应用的AC-LGAD设计

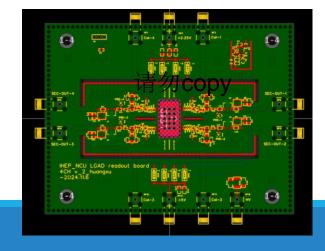
▶ 版图方面: 仿真与设计进行中

针对CEPC TOF应用,设计大面积的 strip型器件 4cm, 2cm, 1cm长, Pitch尺寸, 50um-500um



- ▶ 结构和工艺方面进行调整,以优化电容、信号收集、位置分辨等性能
- ➤ PCB测试板优化设计(束流测试) 4通道快时间信号测试板优化设计(2级放大,低噪声)

参与人员: 李梦朝(博后, 东莞入职), 吴天涯(南昌大学)





### ➤ CEPC Ref-TDR工作

- ▶ 参与物理、软件、探测器、电子学、机械讨论
- ▶ 进行探测器性能评估与结构优化设计
- ▶ 流片厂家联系与沟通
- ➤ 文字撰写(AC-LGAD R&D 设计和性能)

#### ➤ DRD3 AC-LGADs for electron colliders项目

➤ 组织并召集国内外单位讨论AC-LGAD性能研究

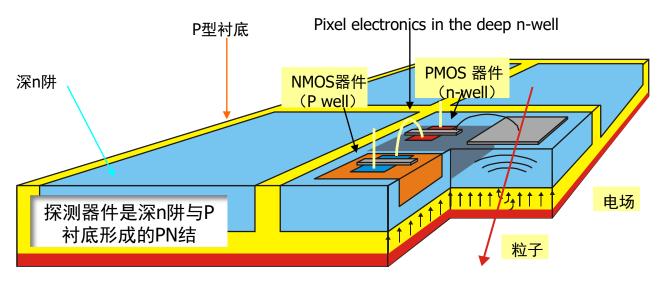
IHEP, JSI, Montenegro team, 山大,南开,郑大,上交,1个国外单位待定



# 高压CMOS硅像素探测器研究

### ▶高压CMOS硅像素探测器

深n阱与衬底间形成耗 尽层,作为探测灵敏区 在深n阱内可放置其他 MOS器件



应用前景: CEPC ITK, LHCb升级等

### 本年度工作:

➤ 基于55nm工艺第二版传感器仿真与sensor测试

合作人员: 李一鸣, 陆卫国, 周扬, 徐子骏, 项治宇等



# 高压CMOS硅像素探测器研究

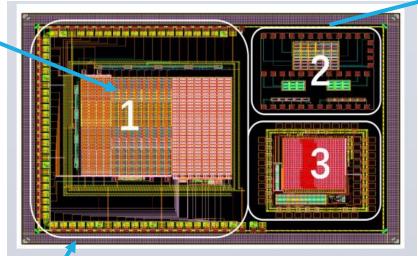
#### ➤ 基于55nm高压工艺-HVCMOS设计(COFFEE2)

像素尺寸40um\*80um, 像素阵列: 32x20

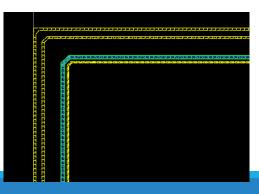
测试单元:深n阱与

金属电极结构调整

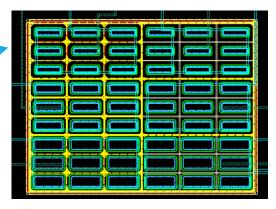
阵列内部像素 传感器设计



芯片整体外围保护环结构设计



#### 仅列出自己的工作



D: Distance between two pixels

Type 1: D:10um, with Pstop

Type 2: D:15um, with Pstop

Type 3: D:20um, with Pstop

Type 4: D:10um, without Pstop

Type 5: D:15um, without Pstop

Type 6: D:20um, without Pstop

合作人员: 李一鸣, 陆卫国, 周扬, 徐子骏, 项治字等

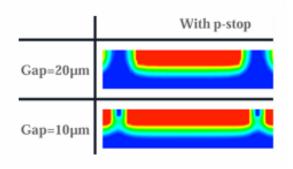


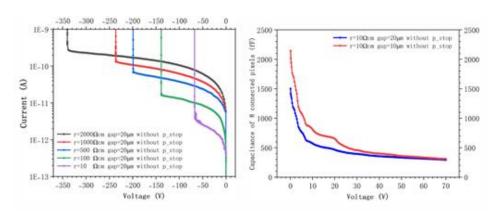
# 高压CMOS硅像素探测器研究

#### > 仿真工作

(项治宇,邓建鹏(浙大学生))

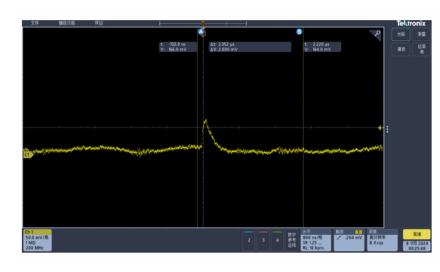
仿真结果与测试结果吻合IV,CV





▶ 测试结果 (项治宇,徐子骏等)

#### Beta与Fe55均有信号响应



合作人员: 李一鸣, 陆卫国, 周扬, 徐子骏, 项治字等



## 抗辐照SiPM器件研究

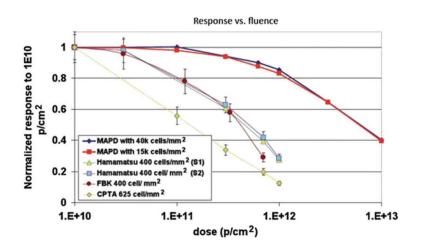
### ▶抗辐照SiPM器件

- ➤工作倍增区的雪崩倍增二极管 (与LGAD不同的是倍增区工艺)
- ▶应用广泛: HERD, LACT, CMS, CEPC量能器等
- ▶天体、高能物理应用需要抗辐照性能
- >目前器件抗辐照性能:

辐照后,增益下降,暗噪声增多,能量分辨下降

一般辐照情况: 1krad or 10<sup>9</sup> n<sub>eq</sub>/cm<sup>2</sup>

	Long term Satellite or Space station application	CEPC requirement
TID does	100 krad	>100 krad
Fluence	~10 <sup>10</sup> n <sub>eq</sub> /cm <sup>2</sup>	>10 <sup>13</sup> n <sub>eq</sub> /cm <sup>2</sup>



### > 本年度工作:

• 第一版SiPM器件 工艺与结构仿真,版图绘制,晶圆购置,提交流片

参与人员: 李梦朝(博后), 孙维益(学生), 张田园(学生), 梁志均

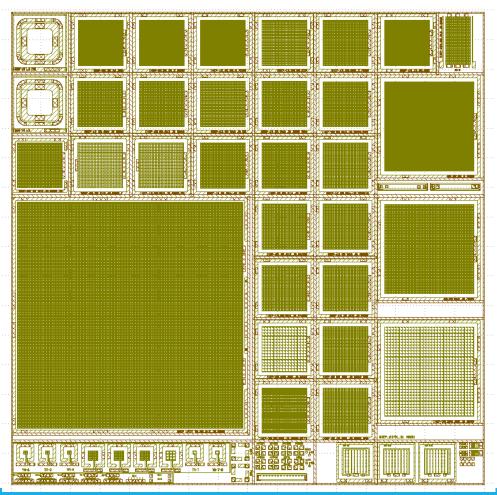


## 抗辐照SiPM器件研究

### >SiPM第一版版图与流片

- 根据应用需求,初步设计了具有不同像素大小,阵列规模的SiPM器件(SiPM size: 1.5x1.5mm, 3x3mm, 7.6x7.6mm, Pixel size: 10um, 20um, 50um, 100um)
- 衬底晶圆购置完成
- 工艺步骤中所需要所有的工艺参数 设计仿真完成
- •2024年6月提交流片

•赵梅,李梦朝(博后),梁志均





# 其他工作: LGAD探测器研究与应用拓展

### ▶ LGAD探测器研究与应用拓展

#### X射线探测

- Fe55初步测试(多学科、天体)
- 后续进行时间、能量分辨测试
- 针对X射线探测应用进行LGAD优化设计

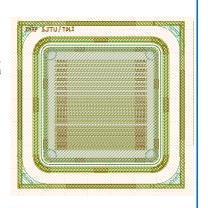
项目申请: 2025年国家重点研发计划项目-大装置前沿研究专项

合作人员: 徐伟(多学科), 李秋菊(多学科), USP(巴西)

#### Darkshine

针对这一应用设计芯片流片 完成了时间、位置分辨测试 (上交)

发表论文一篇 (NST)

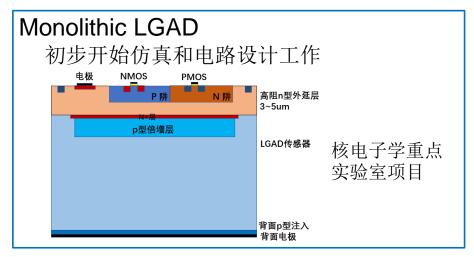


合作人员: 李梦朝(博后),梁志均,刘坤(上交-李所)

#### Lumical

- ➤ ATLAS BMA(LUCID): 提供器件应用于luminosity测试,根据需求新设计器件
- CEPC Lumical:
   LGAD方案讨论与完善 新型LGAD性能仿真

合作人员: 杨轩(博后), 樊云云 石澔玙, 张雷(南大), 侯书云



合作人员: 孙维益(学生), 黄文豪(学生), 叶竞波



# 项目

### 本年度申请项目:

- 1、核电子学重点实验室项目: LGAD探测器与读出电路集成化研究,20万,2024.6-2025.3,负责人,获批
- 2、科技部国家重点研发(MOST4),高能量粒子加速器相关粒子探测关键技术研制和验证,2000万,2025年-2029年,骨干成员,负责飞行时间探测器
- 3、2025年国家重点研发计划项目-大装置前沿研究专项-"基于X射线-原子核系统的量子调控研究 (基础研究)"课题三--原子核共振散射探测谱仪及算法研发, 骨干成员, 负责LGAD探测器(100ps)

### 项目情况:

项目名称	项目类别	项目经费	本人工作	起止时间
ATLAS实验Phase 2探测器升级	科技部国家重点 研发	2200万	HGTD LGAD传感器负责人 Timing pixel 探测器	2024年-2028年
LGAD探测器与读出电路集成化研究	核电子学重点实 验室项目	20万	项目负责人	2024.6 - 2025.3
抗辐照的SiPM器件研究	所创新	130万	SiPM器件设计与测试	2023年-2025年
用于粒子探测的高时空分辨率硅雪崩探测器关键 技术研究	国家自然科学基 金面上项目	63万	AC-LGAD设计与测试总体 负责人	2022.1-2025.12
ATLAS实验探测器Phase 2升级	国家自然科学基 金,国际合作	3350万	负责HGTD LGAD传感器	2020.1-2024.12

22/11/2024 年度考核报告,赵梅,2024.11.22 23



# 文章会议报告

#### ▶已发表: 4篇

- 1、Weiyi Sun, Mengzhao Li, Zhijun Liang, <u>Mei Zhao</u>, ..., The performance of AC-coupled Strip LGAD developed by IHEP, <u>Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A</u>: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 1062, 2024(通讯作者)
- 2、Kang Liu, Meng-Zhao Li, Jun-Hua Zhang, Wei-Yi Sun, Yun-Yun Fan, Zhi-Jun Liang, Yu-Feng Wang, Mei Zhao, Kun Liu, Performance of AC-LGAD strip sensors designed for the DarkSHINE experiment, Nuclear Science and Techniques, Volume 35, 2024 (通讯作者)
- 3、Jiaying Zhou, Mengzhao Li, Yuekun Heng, Weimin Song, Weiyi Sun, Tianyuan Zhang, Mei Zhao, Zhijun Liang, The properties of LGAD with different sensitive areas, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 170074, 2024.
- 4、Zhuojun Chen, Ruoshi Dong, Leyi Li, Yiming Li, Weiguo Lu, Yunpeng Lu, Ivan Peric, Jianchun Wang, Zhiyu Xiang, Kunyu Xie, Zijun Xu, Hui Zhang, Mei Zhao, Yang Zhou, Hongbo Zhu, Xiaoyu Zhu, Feasibility study of CMOS sensors in 55 nm process for tracking, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 1069, 2024.

#### ▶待发表: 1篇

- 5、Weiyi Sun, Mengzhao Li, Tianyuan Zhang, <u>Mei Zhao</u>, ..., Development of high-precision time detector based on strip LGAD for collider experiments. 投稿NST, 最终版修改阶段, 2024(通讯作者)
- **▶专利:** 雪崩二极管器件与电子学电路集成,撰写中



# 文章会议报告

### ▶会议报告: 国内4次, 国际7次

赵梅	HGTD (long) week (Monday-Friday)	2024/2/5	2024/2/9	CERN	国际会议	是	Status of sensor pre-production	口头报告
赵梅	The 2024 European Edition of the International Workshop on the Circular Electron-Positron Collider (CEPC)	2024/4/8	2024/4/11	Marseille, France	国际会议	是	LGAD based 4D outer tracker and time of flight	分组报告
赵梅	HGTD (mini) week (Monday-Thursday) during ATLAS upgrade week	2024/4/5	2004/4/18	CERN	国际会议	是	Status of preproduction/UBM	口头报告
赵梅	第四届半导体辐射探测器研讨会	2024/5/23	2024/5/26	山东青岛	国内会议	是	The effects of irradiation on LGAD developed by IHEP	分组报告
赵梅	HGTD Week in Beijing, China	2024/7/8	2024/7/13	北京	国际会议	是	Main sensor QC status	口头报告
赵梅	第二十二届全国核电子学与核探测技术学 术年会暨第十二届全国先进气体探测器研 讨会(NED&CAGD2024)	2024/7/15	2024/7/17	山东青岛	国内会议	是	Researches of irradiation- resistant LGAD detector for ATLAS HGTD	分组报告
赵梅	2024全国光电科学与工程学术会议	2024/7/26	2024/7/28	四川成都	国内会议	是	快时间探测器及其应用	分组报告
赵梅	中国物理学会高能物理分会第十四届全 国粒子物理学术会议	2024/8/12	2024/8/17	山东青岛	国内会议	是	Development of LGAD for ATLAS HGTD and CEPC TOF out-tracker	分组报告
赵梅	The 2024 international workshop on the high energy Circular Electron Positron Collider (CEPC)	2024/10/22	2024/10/27	浙江杭州	国际会议	是	LGAD sensor development (From ATLAS high granularity timing detector to future timing detector)	分组报告
赵梅	HGTD (mini) week (Monday-Thursday) during ATLAS upgrade week	2024/11/11	2024/11/13	CERN	国际会议	是	Sensor acceptance - discussion about the document	口头报告
赵梅	第十届中国LHC物理会议(CLHCP2024 青岛)	2024/11/13	2024/11/17	山东青岛	国内会议	是	ATLAS upgrade	口头报告

#### ▶ 参与指导学生: 5名

孙维益: 高能所, QT local supervisor, 副导师, IHEP-IME LGAD器件测试与分析

任浩泉,科大,QT Technical supervisor,HGTD项目USTC-IME LGAD器件测试

Iskra Velkovska, JSI, QT Technical supervisor, LGAD器件辐照性能测试

邓建鹏,浙江大学,HVCMOS器件TCAD仿真

张晓旭,南京大学,AC-LGAD仿真与测试



# 下年度工作计划

- ▶ LGAD探测器研究(人员?)
  - · ATLAS HGTD: 正式生产流片与芯片测试; 质量监控, 联调测试, 束流测试等
  - · LGAD探测器性能研究
  - · 应用拓展(X射线与Lumical)
  - Monolithic LGAD (人员?)
- ▶ AC-LGAD 探测器研究 (人员?)
  - · CEPC Ref-TDR工作
  - · AC-LGAD器件流片与测试(两次) (人员?)
  - · MOST4 TOF系统样机初步搭建
  - · 时间与位置分辨能力测试(含束流测试)
  - 位置重建算法优化(人员?)
- ▶ 高压CMOS硅像素探测器件研究
  - 第三、四版基于55nm工艺HVCMOS器件设计、流片(sensor部分);
  - sensor辐照性能研究;
- ▶ 抗辐照SiPM芯片研制
  - 芯片测试与辐照性能研究 (人员?)
- 领导交予的其他工作

欢迎所里各组更多人员参与LGAD、SiPM方面工作 随时联系我!

赵梅: zhaomei@ihep.ac.cn, 主楼B224

26